17,09

Энергетический спектр изомера № 3 фуллерена C₈₂ симметрии C₂

© И.Е. Кареев¹, В.П. Бубнов¹, А.И. Котов¹, Б.В. Лобанов², А.И. Мурзашев^{2,¶}, И.А. Румянцев²

¹ Институт проблем химической физики РАН,

Черноголовка, Россия

² Марийский государственный университет,

Йошкар-Ола, Россия

[¶] E-mail: nanotubes59@mail.ru

(Поступила в Редакцию 18 мая 2016 г. В окончательной редакции 5 июня 2016 г.)

В рамках модели Хаббарда в приближении статических флуктуаций вычислен энергетический спектр фуллерена C_{82} (изомер № 3 симметрии C_2). На основе энергетического спектра смоделированы спектры оптического поглощения данного изомера в нейтральном и анионных состояниях с одним, двумя, тремя и четырьмя дополнительными электронами. Проведено сравнение расчетных оптических спектров в нейтральном и моноанионном состояниях с известными экспериментальными спектрами.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проекты № 14-08-00824-а, 16-03-00810-а) и гранта МарГУ № 2014-003а.

DOI: 10.21883/FTT.2017.01.43974.194

1. Введение

Высшие фуллерены начиная с фуллерена С78 имеют пять и большее число изомеров, подчиняющихся правилу изолированных пятиугольников. Согласно этому правилу, наиболее устойчивыми являются те изомеры, в которых каждый пятиугольник окружен шестиугольниками. Фуллерен С82 имеет девять таких изомеров. Среди этих изомеров имеется лишь один, который получен при электродуговом синтезе и выделен в чистом виде [1,2]. Этот изомер, охарактеризованный как изомер № 3 согласно атласу фуллеренов [3], имеет симметрию группы С₂ и экспериментально исследован спектроскопическими методами в нейтральном и моноанионном состояниях в результате реакции при взаимодействии с донором электронов тетракис(диметиламино)этиленом [1]. В анионном состоянии фуллерен C_{82} (C_2) с зарядом от -2 до -4 был последовательно сгенерирован электрохимическим методом, и при комнатной температуре в растворе о-дихлорбензола были зарегистрированы оптические спектры поглощения анионов [2]. Однако, как отмечают авторы, эти спектры не отражают реальной картины, поскольку в растворе одновременно могут присутствовать анионы в различных зарядовых состояниях. Таким образом, в настоящее время экспериментальные оптические спектры поглощения анионов C₈₂²⁻, C^{3-}_{82} и C^{4-}_{82} неизвестны и не смоделированы расчетными методами.

Другие синтезированные изомеры фуллерена C_{82} , такие как C_s (№ 6), C_{3v} (№ 8), C_{2v} (№ 9), существуют лишь в виде эндоэдральных комплексов с внедренными внутрь каркаса фуллерена атомами или молекулами, содержащими металлы третьей группы и лантаноиды [4–7]. Ранее нами в рамках модели Хаббарда [8,9] на основе энергетических спектров фуллерена C_{82} (изомеры C_{2v}

и C_s) были смоделированы спектры оптического поглощения эндоэдральных фуллеренов Ho@C82, Gd@C82 и $Gd_2C_2@C_{82}$, которые имели хорошее согласие с экспериментальными спектрами. В рамках предложенной модели расчет оптических спектров поглощения эндоэдральных фуллеренов был выполнен в предположении, что внедренная в углеродный каркас частица выступала донором электронов, передаваемых на фуллереновую оболочку. Расчетные оптические спектры моделировались при разной величине передаваемого заряда (от одного электрона до четырех). Апробация модели Хаббарда в случае эндоэдральных фуллеренов показала хорошее совпадение расчетных и экспериментальных спектров оптического поглощения (СОП). В [8,9] показано, что π -электронная подсистема фуллеренов может быть описана как сильно коррелированная система, что позволило идентифицировать полосы оптического поглощения Ho@C₈₂, Gd@C₈₂ и Gd₂C₂@C₈₂ с разным зарядовым состоянием фуллерена С82, определить в них величину переноса заряда, а также объяснить смещение полос поглощения Но@С82 и Gd@C82 при взаимодействии с донором электронов K(18-crown-6)[$C(C_6Cl_5)_3$].

Представляют интерес вычисление энергетического спектра и моделирование на его основе СОП изомера \mathbb{N}_2 3 фуллерена \mathbb{C}_{82} (симметрии \mathbb{C}_2) в нейтральном и различных зарядовых (-1, -2, -3 и -4) состояниях в рамках модели Хаббарда. Применение модели Хаббарда позволяет учесть кулоновское взаимодействие электронов на одном узле и смоделировать СОП исследуемого фуллерена. Ранее в [2] был вычислен СОП фуллерена \mathbb{C}_{82} (\mathbb{C}_2) \mathbb{N}_2 3 в рамках стандартного TD-DFT-метода, не учитывающего эффекты сильной корреляции, которые имеют место в хаббардовских системах. Добиться качественного совпадения расчетного СОП с экспериментальным авторам [2] удалось лишь искусственным

E V	14	T	E .V	14	T	E .V	14	T	E .V	14	T
E,ev	М	L	E, ev	М	L	E, ev	М	L	E, ev	М	L
-5.194	1	0	-2.463	1	6	1.110	1	0	3.841	1	6
-5.048	1	1	-2.386	1	7	1.255	1	1	3.918	1	7
-5.031	1	1	-2.207	1	7	1.272	1	1	4.097	1	7
-5.022	1	2	-2.137	1	6	1.281	1	2	4.167	1	6
-4.758	1	2	-2.016	1	6	1.546	1	2	4.288	1	6
-4.752	1	2	-1.804	1	7	1.552	1	2	4.499	1	7
-4.743	1	1	-1.684	1	7	1.560	1	1	4.619	1	7
-4.700	1	2	-1.594	1	6	1.603	1	2	4.710	1	6
-4.691	1	3	-1.524	1	6	1.612	1	3	4.779	1	6
-4.393	1	3	-1.475	1	7	1.910	1	3	4.828	1	7
-4.363	1	3	-1.456	1	6	1.941	1	3	4.847	1	6
-4.320	1	2	-1.391	1	7	1.984	1	2	4.913	1	7
-4.312	1	3	-1.387	1	6	1.992	1	3	4.917	1	6
-4.285	1	4	-1.317	1	7	2.018	1	4	4.987	1	7
-4.241	1	4	-1.266	1	8	2.063	1	4	5.038	1	8
-4.222	1	3	-1.221	1	8	2.082	1	3	5.083	1	8
-3.971	1	4	-1.213	1	7	2.333	1	4	5.091	1	7
-3.858	1	4	-1.210	1	8	2.445	1	4	5.094	1	8
-3.857	1	3	-1.208	1	7	2.466	1	3	5.096	1	7
-3.803	1	3	-1.174	1	7	2.500	1	3	5.130	1	7
-3.785	1	4	-1.017	1	8	2.519	1	4	5.287	1	8
-3.770	1	5	-0.989	1	7	2.533	1	5	5.315	1	7
-3.766	1	4	-0.956	1	8	2.537	1	4	5.347	1	8
-3.700	1	5	-0.936	1	7	2.604	1	5	5.367	1	7
-3.665	1	4	-0.884	1	7	2.639	1	4	5.420	1	7
-3.394	2	5	-0.797	1	8	2.910	2	5	5.507	1	8
-3.366	1	4	-0.699	1	8	2.938	1	4	5.605	1	8
-3.355	1	5	-0.646	1	7	2.949	1	5	5.658	1	7
-3.339	1	4	-0.608	1	8	2.965	1	4	5.696	1	8
-3.308	1	6	-0.549	1	7	2.996	1	6	5.755	1	7
-3.302	1	5	-0.536	1	8	3.002	1	5	5.767	1	8
-3.266	1	5	-0.419	1	8	3.038	1	5	5.885	1	8
-3.261	1	6	-0.395	1	9	3.043	1	6	5.908	1	9
-3.215	1	6	-0.210	1	9	3.069	1	6	6.094	1	9
-3.204	1	5	-0.156	1	8	3.100	1	5	6.147	1	8
-3.096	1	5	-0.103	1	9	3.208	1	5	6.040	1	9
-3.080	1	6	-0.102	1	8	3.223	1	6	6.201	1	8
-3.017	1	6	-0.050	1	8	3.286	1	6	6.254	1	8
-2.925	1	5	-0.045	1	9	3.378	1	5	6.259	1	9
-2.853	1	5	0.000	1	9	3.451	1	5	6.304	1	9
-2.622	1	6				3.682	1	6			

Энергетический спектр изомера № 3 (С2) фуллерена С82

смещением всех энергетических уровней на 0.3 eV. В то же время, как показано нами [8,9], моделирование СОП на основе энергетических спектров, полученных в рамках модели Хаббарда, дает хорошее совпадение с экспериментом для изомеров C_s (No 6) и C_{2v} (No 9) фуллерена C_{82} .

Постановка задачи и энергетический спектр фуллерена C₈₂(C₂)

Как и в работах [8,9], π -электронная подсистема фуллерена С₈₂ (изомер C_2) будет описываться моделью

Хаббарда

$$\hat{H} = \varepsilon \sum_{i,\sigma} n_{i,\sigma} + B \sum_{i,j\sigma} (a^+_{i\sigma} a_{j\sigma} + a^+_{j\sigma} a_{i\sigma}) + U \sum_i n_{i,\uparrow} n_{i,\downarrow}.$$
(1)

Здесь ε — собственная энергия электронов, B — интеграл перескока, U — параметр, учитывающий кулоновское взаимодействие (отталкивание) электронов на одном узле, $a_{i\sigma}^+$ и $a_{i\sigma}$ — соответственно операторы рождения и уничтожения электронов на узле i со спином σ , $n_{i,\sigma}$ — оператор числа частиц. В первом слагаемом ε играет роль химического потенциала, взятого с противоположным знаком. Второе слагаемое представляет перескоки электронов с узла на узел, что

приводит к расщеплению атомного уровня π -электронов на совокупность молекулярных орбиталей. Третье слагаемое учитывает взаимодействие двух π -электронов, оказавшихся в результате перескоков на одном узле и имеющих противоположные спины вследствие запрета Паули.

Энергетический спектр системы, описываемой гамильтонианом (1), для изомера № 3 (С2) фуллерена С₈₂ вычислен в приближении статических флуктуаций. В общем виде приближение статических флуктуаций было предложено в работах [10,11]. В рамках этого приближения удается описать расщепление энергетических уровней на две хаббардовские подзоны. Физический смысл указанного приближения состоит в том, что в рамках этого приближения точно вычисляется как кулоновское расщепление атомных состояний, так и расщепление, связанное с перескоками электронов, учитываемое вторым слагаемым в (1). Влияние перескоков на кулоновское расщепление атомных состояний и внутриузельного кулоновского отталкивания на перескоки далее уже не учитывается, потому что основой приближения является допущение

$$\left| B \sum_{i,j,\sigma} (a_{i\sigma}^+ a_{j\sigma} + a_{j\sigma}^+ a_{j\sigma}), U \sum_i n_{i,\uparrow} n_{i,\downarrow} \right| \approx 0,$$

которое, как было отмечено в [11], означает, что $n_{i,\sigma}(t) = {
m const.}$

Энергетический спектр, вычисленный в рамках выбранного приближения, приведен в таблице. Он состоит из 162 уровней, из которых два уровня двукратно вырождены. При вычислении энергетического спектра параметры модели Хаббарда были выбраны следующими: $U = 6.30 \,\text{eV}, B = -0.90 \,\text{eV}$. Такой выбор параметров обусловлен тем, что он обеспечивает наилучшее согласие расчетного спектра оптического поглощения с экспериментальными данными. При выбранных параметрах ширина энергетической щели между хаббардовскими подзонами (щели ВЗМО-НСМО, верхняя заполненная молекулярная орбиталь-нижняя свободная молекулярная орбиталь) равна 1.11 eV. Приблизительно при таком значении энергии начинается оптическое поглощение нейтрального C_{82} (C_2), измеренное в [1,2]. В колонке M(см. таблицу) приведены значения кратностей вырождения уровней, а в колонке L — номера молекулярных оболочек, которые определены в соответствии с группой изучаемого изомера симметрии С2. Эта группа содержит два одномерных неприводимых представления, вследствие чего в энергетическом спектре могут присутствовать только невырожденные уровни двух типов. Однако в спектре, представленном в таблице, имеются два уровня со степенью вырождения, равной двум. Это случайное вырождение связано с тем обстоятельством, что при расчете не были учтены различия в длинах связей между неэквивалентными узлами в углеродном каркасе. Например, в случае фуллерена С₆₀ учет наличия двух типов связей в углеродном каркасе приводит к тому, что девятикратно вырожденный уровень энергии, получаемый в расчете без учета длин связей, расщепляется на два уровня с кратностями вырождения 4 и 5 [12,13]. Расстояние между данными уровнями составляет приблизительно 0.01 eV и не влияет существенным образом на спектры оптического поглощения.

3. Спектры оптического поглощения

Как показано в наших работах [8,9,12-15], при учете кулоновского отталкивания энергетический спектр фуллеренов разбивается на две группы уровней — хаббардовские подзоны ("верхнюю" и "нижнюю"). Состояния "верхней" подзоны образованы состояниями электронов с двукратным занятием узла, "нижней" — однократным. Расстояние между соответствующими уровнями двух подзон равно параметру U. В основном состоянии "верхняя" подзона пуста, "нижняя" полностью заполнена. Следовательно, оптические переходы в подсистеме π -электронов в фуллерене могут происходить между состояниями "верхней" и "нижней" подзон. В [13] на примере фуллерена С60 было показано, что СОП фуллеренов формируется двумя типами переходов: разрешенными по симметрии и запрещенными. Вторые становятся возможными вследствие температурных искажений каркаса фуллерена. Очевидно, что интенсивность разрешенных переходов должна быть намного больше, чем запрещенных. Так, в фуллерене С₆₀ интенсивность разрешенных переходов на два порядка выше, чем для запрещенных.

Исходя из этого СОП рассматриваемого изомера моделировался как на разрешенных правилами отбора, так и на запрещенных этими правилами переходах. Разрешенными являются переходы между уровнями, относящимися к соседним оболочкам ($\Delta L = \pm 1$). Запрещенные переходы становятся возможными с малой интенсивностью вследствие нарушения симметрии, которое возникает из-за тепловых колебаний углеродного каркаса фуллерена. Вследствие более низкой симметрии рассматриваемого фуллерена C_{82} (изомер C_2) различие интенсивностей разрешенных и запрещенных переходов должно быть меньше, чем в высокосимметричном фуллерене С₆₀. Приемлемое согласие с экспериментальными кривыми СОП для рассматриваемого фуллерена достигается при различии интенсивностей "разрешенных" и "запрещенных" переходов в 10 раз.

На рис. 1 совмещены кривые СОП фуллерена C_{82} симметрии C_2 (\mathbb{N}_2 3) в нейтральном состоянии, вычисленного нами (сплошная линия) и измеренного в работе [1] (пунктирная линия). Максимумы основных полос поглощения, наблюдаемых в эксперименте, находятся приблизительно при 500, 580, 740 и 880 nm, также имеется слабо выраженная полоса поглощения при 1100–1200 nm. Теоретическая кривая в рассматриваемой области длин волн практически полностью образована запрещенными переходами. Из рис. 1 видно,



Рис. 1. СОП фуллерена C_{82} симметрии C_2 (№ 3) в нейтральном состоянии. Сплошная кривая — расчетный спектр, пунктирная кривая — экспериментальные данные [1].



Рис. 2. Расчетный СОП фуллерена C_{82} симметрии C_2 (№ 3) в нейтральном состоянии в ультрафиолетовой области.

что теоретический СОП довольно хорошо согласуется с экспериментальным спектром. Так, практически совпадает положение максимумов поглощения при 500, 580 и 740 nm. Полоса поглощения, в эксперименте обнаруживаемая при 880 nm, в расчетном спектре смещена к 940 nm. Однако полученный нами теоретический спектр не объясняет полосы поглощения в области 1100–1200 nm.

Переходы, разрешенные согласно правилам отбора, формируют спектр поглощения и в коротковолновой области. На рис. 2 представлен расчетный спектр, образованный только разрешенными переходами. Наиболее сильно выраженная полоса поглощения расположена при 200 nm. Менее интенсивные полосы находятся при 155, 175, 185, 210, 225, 250 и 280 nm. Поскольку на данный момент нет экспериментальных данных по поглощению фуллерена C₈₂ симметрии C₂ (№ 3) в ультрафиолетовой области, представленный спектр носит предсказательный характер.

Значительный интерес представляют СОП фуллерена С₈₂ симметрии С₂ (№ 3) в анионном состоянии. Эти спектры исследуемого фуллерена в зарядовом состоянии 1- были экспериментально получены в работе [1]. Зарядовое состояние 1- рассматриваемого фуллерена было создано химическим способом, и поэтому оно является стационарным и однородным в растворе. В работе [2] зарядовое состояние 1- фуллерена С82 симметрии С₂ (№ 3) было получено электрохимическим способом и является нестационарным. Теоретическая кривая (сплошная линия), рассчитанная по модели Хаббарда, и экспериментальная кривая (пунктирная линия) моноаниона фуллерена С₈₂, полученная в [1], совмещены на рис. 3, а, а экспериментальный спектр, полученный в [2], совмещен с теоретическим на рис. 3, b. Из рис. 3 видно, что на кривой, полученной в [1] (рис. 3, *a*), имеют место полосы поглощения с максимумами при 620, 670, 810, 880 и 1440 nm. На кривой же, полученной в [2] (рис. 3, b), кроме указанных полос также имеется полоса



Рис. 3. СОП фуллерена C_{82} симметрии C_2 (№ 3) в состоянии аниона C_{82}^{1-} . *а* — сравнение с экспериментальными данными из работы [1], *b* — сравнение с кривой из работы [2]. Сплошная кривая — расчетный спектр, пунктирные кривые — экспериментальные спектры поглощения.

при 1120 nm, а максимум полосы 1440 nm смещен к значению 1520 nm. Кроме того, в спектре, полученном в [2], в области длин волн, больших 1500-2000 nm, имеется полоса поглощения с максимумом при 1850 nm. На кривой, полученной в [1], где измерения проводились в диапазоне до 1600 nm, эта полоса, если она есть, не попала в диапазон измерений. Отметим тот факт, что интенсивности полос поглощения в области от 620 до 880 nm на кривой, полученной в [1], существенно различаются, тогда как на кривой из работы [2] они почти совпадают. Имеющие место различия кривых СОП связаны с нестационарными процессами рекомбинации ионов в растворе с ионами C_{82}^{1-} в случае [2]. Экспериментальные кривые в обоих случаях на качественном уровне совпадают с теоретической. Полосе при 620 nm на экспериментальной кривой соответствует максимум при 600 nm в теоретическом спектре. Экспериментальный максимум при 670 nm на теоретической кривой представлен пиком при 680 nm. Имеющийся на теоретической кривой пик при 760 nm может быть соотнесен как с тем же максимумом при 670 nm, так и со следующим за ним максимумом при 810 nm. Теоретическая полоса поглощения с максимумом на 910 nm объясняет экспериментальную полосу при 880 nm. Полоса поглощения с максимумом при 1440 nm (согласно [1]) или при 1520 nm (согласно [2]) на теоретической кривой представлена широкой полосой в области от 1300 до 1600 nm. На теоретической кривой полоса поглощения с максимумом при 1120 nm отсутствует, что согласуется с [1] и противоречит [2]. Также на теоретической кривой отсутствует полоса поглощения с максимумом при 1850 nm. Тот факт, что она отсутствует на кривой для нейтрального состояния, указывает на то, что ее природа чисто электронная и очевидно связана с зарядовым состоянием исследуемого фуллерена.

Различие экспериментальных кривых СОП, полученных в работах [1] и [2], может быть объяснено тем, что, как отмечалось выше, в [1] зарядовое состояние C_{82}^{1-} стационарно и однородно по всему раствору, а в [2] стационарность и однородность не гарантируются. Методика эксперимента в этой работе такова, что при подаче соответствующего напряжения на электроды вблизи катода возникают заряженные молекулы фуллерена С82. Заряд этих молекул контролируется напряжением на электродах: например, при напряжении в 1.0 V вблизи катода формируются частицы C₈₂ с зарядом -1, при 1.35 V — ионы с зарядом -2, при 1.70 V — ионы с зарядом -3, при 1.85 V — ионы с зарядом -4. Однако, как утверждают авторы работы [2], в объеме раствора зарядовое состояние молекул может отличаться от зарядового состояния частиц вблизи катода. Поэтому, например, при напряжении 1.35 V в объеме раствора помимо ионов C_{82}^{2-} будут содержаться и C_{82}^{1-} , при напряжении 1.70 V кроме ионов C_{82}^{3-} , будут содержаться и ионы C_{82}^{1-} и C_{82}^{2-} , а при напряжении 1.85 V наряду с ионами C_{82}^{4-} останется доля ионов C_{82}^{1-} , C_{82}^{2-} и C_{82}^{3-} .



Рис. 4. СОП фуллерена C_{82} симметрии C_2 (№ 3) в состоянии аниона C_{82}^{2-} . Сплошная кривая — расчетный спектр, пунктирная кривая — экспериментальный спектр из работы [2].

Это затрудняет анализ положения полос в спектре оптического поглощения. Поэтому достоверно в рамках эксперимента из работы [2] может быть измерен СОП только ионов C_{82}^{1-} при напряжении на электроде 1.0 V. Но и в этом состоянии, судя по наличию "лишней" полосы поглощения с максимумом при 1120 nm, имеют место процессы рекомбинации, вносящие вклад в СОП.

СОП для анионов C_{82}^{2-} , C_{82}^{3-} и C_{82}^{4-} в растворе были получены в работе [2], но эти зарядовые состояния, как отмечают авторы, нестационарны. Тем не менее проанализируем эти кривые и сравним их с нашими расчетными данными. На рис. 4 пунктирной линией изображены кривые СОП дианиона C_{82}^{2-1} , измеренные в [2], сплошной линией — кривые СОП, вычисленные нами. Из рисунка видно, что на экспериментальной кривой имеются полосы поглощения с максимумами при 650, 830, 1340 и 1600 nm. На теоретической кривой имеются полосы поглощения, максимумы которых расположены при 720, 900 и 1720 nm, соответствующие, по всей видимости, полосам поглощения на экспериментальной кривой при 650, 830 и 1600 nm. Отметим, что полоса поглощения на теоретической кривой с максимумом при 1720 nm связана с разрешенным переходом электронов с уровня 1.110 eV, который становится занятым при переносе двух электронов, на уровень с энергией 1.984 eV. Полосе поглощения при 1340 nm на экспериментальной кривой соответствует небольшое вздутие при 1280 nm на теоретической кривой. В целом теоретическая кривая на качественном уровне достаточно хорошо описывает эксперимент.

Рассмотрим кривые СОП для трианиона C_{82}^{3-} (рис. 5). Здесь совпадение теоретической и экспериментальной кривой хуже, чем для дианиона. Полосе при 630 nm на экспериментальной кривой соответствует полоса при 720 nm. Полосам поглощения при 820 и 980 nm, наблюдаемым в эксперименте, по-видимому, отвечает пара



Рис. 5. СОП фуллерена C_{82} симметрии C_2 (№ 3) в состоянии аниона C_{82}^{3-} . Сплошная кривая — расчетный спектр, пунктирная кривая — экспериментальный спектр из работы [2].



Рис. 6. СОП фуллерена C_{82} симметрии C_2 (No 3) в состоянии аниона C_{82}^{4-} . Сплошная кривая — расчетный спектр, пунктирная кривая — экспериментальный спектр из работы [2].

теоретических максимумов, расположенных при 900 и 980 nm. Явно выраженный экспериментальный максимум при 1300 nm на теоретической кривой отсутствует; ближайшая к этому максимуму теоретическая полоса расположена при 1160 nm и имеет сравнительно малую интенсивность. Экспериментальному значению максимума при 1600 nm соответствует теоретическое значение при 1750 nm. Отметим также, что интенсивность полосы поглощения с максимумом при 1750 nm растет в случае теоретической кривой при переходе от иона C_{82}^{2-} к иону C_{82}^{3-} , так же как и в случае экспериментальной полосы полосы с максимумом при 1600 nm. Смещение максимума полосы поглощения на теоретической кривой от 1720 nm при увеличении заряда от -2 до -3 в длинноволновую область к значению 1750 nm теоретически объясняется тем, что в ионе C_{82}^{3-} становится занятым уровень 1.272 eV, следующий за 1.255 eV, вследствие чего интенсивность полос поглощения, формируемых переходами с этих двух уровней, увеличивается примерно вдвое, а их максимум смещается в область длинных волн. Почему это не наблюдается в эксперименте, непонятно. Можно предположить, что это связано с процессами рекомбинации ионов.

Что касается тетрааниона C_{82}^{4-} , то можно отметить, что согласие теории и эксперимента практически отсутствует (рис. 6). Единственная полоса поглощения, положение которой приблизительно сходится с экспериментом, расположена при 1760 nm. Однако, согласно данным эксперимента, интенсивность этой полосы при переходе от C_{82}^{3-} к C_{82}^{4-} должна уменьшаться до значения, которое имеет место в ионе C_{82}^{2-} , но на теоретической кривой наблюдается обратная ситуация. Отметим, что ранее [8,9,12–15] в рамках используемого в настоящей работе подхода нам удавалось объяснить СОП различных эндоэдральных фуллеренов с разными величинами переноса заряда. Такое сильное несогласие экспериментальной и теоретической кривых может иметь место по двум причинам. Первая может быть связана с несовершенством модели, ее несоответствием случаю переноса четырех электронов; вторая причина (на наш взгляд, наиболее вероятная) может быть следствием образования в растворе всевозможных связанных состояний анионов C_{82}^{1-} , C_{82}^{2-} , C_{82}^{3-} и C_{82}^{4-} .

Представляют интерес экспериментальное изучение эндоэдральных комплексов на основе рассмотренного изомера фуллерена C_{82} и сравнение их СОП с нашими результатами. Можно сделать предположение, что в случае валентности внедренного комплекса больше двух в СОП будет иметь место полоса поглощения с максимумом при 1600 nm. Интенсивность этой полосы должна монотонно расти при росте валентности внедренного комплекса. В литературе нам не удалось найти работ по эндоэдральным комплексам на основе фуллерена C_{82} (изомер № 3 симметрии C_2).

4. Заключение

Описание пустого фуллерена C_{82} (изомер № 3 симметрии C_2) в рамках модели Хаббарда в режиме сильных корреляций позволяет смоделировать СОП для нейтральной молекулы и ее анионов C_{82}^{1-} , C_{82}^{2-} и C_{82}^{3-} , которые находятся в хорошем согласии с экспериментальными спектрами. Однако не удалось удовлетворительно описать экспериментально наблюдаемый спектр тетрааниона C_{82}^{4-} , что, вероятно, связано с особенностью техники эксперимента в [2]. Таким образом, представление о фуллеренах как сильно коррелированной π -электронной подсистеме позволяет на качественном уровне объяснить СОП фуллерена C_{82} и его анионов.

Список литературы

- M. Fujitsuka, A. Watanabe, O. Ito, K. Yamamoto, H. Funasaka, T. Akasaka, J. Phys. Chem. B 103, 9519 (1999).
- [2] M. Zalibera, A.A. Popov, M. Kalbac, P. Rapta, L. Dunsch. Chem. Eur. J. 14, 32, 9960 (2008).
- [3] P.W. Fowler, D.E. Manolopoulous. An atlas of fullerenes. Clarendon, Oxford (1995). 256 p.
- [4] A.A. Popov, S. Yang, L. Dunsch. Chem. Rev. 113, 5989(2013).
- [5] C.R. Wang, T. Kai, T. Tomiyama, T. Yoshida, Y. Kobayashi, E. Nishibori, M. Takata, M. Sakata, H. Shinohara. Angew. Chem., Int. Ed. 40, 397 (2001).
- [6] А.В. Елецкий. УФН 170, 2, 113 (2000).
- [7] H. Shinohara. Rep. Prog. Phys. 63, 843 (2000).
- [8] И.Е. Кареев, В.П. Бубнов, А.И. Мурзашев, Б.В. Лобанов. ФТТ **57**, 2254 (2015).
- [9] В.П. Бубнов, И.Е. Кареев, Б.В. Лобанов, А.И. Мурзашев, В.М. Некрасов. ФТТ 58, 1639 (2016).
- [10] В.В. Лоскутов, Г.И. Миронов, Р.Р. Нигматуллин. ФНТ 26, 282 (1997).
- [11] Р.Р. Нигматуллин, А.А. Хамзин, И.И. Попов. ЖЭТФ 141, 1 (2012).
- [12] Г.И. Миронов, А.И. Мурзашев. ФТТ 53, 2273 (2011).
- [13] Б.В. Лобанов, А.И. Мурзашев. Изв. вузов. Физика 59, 88 (2016).
- [14] А.И. Мурзашев, Т.Э. Назарова. ЖЭТФ 146, 1026 (2014).
- [15] Б.В. Лобанов, А.И. Мурзашев. ФТТ 55, 797 (2013).